PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-322169

(43)Date of publication of application:

12.11.1992

(51)Int.CI.

H02M 7/48 H02M 7/5387 H05B 41/24 // H02M 1/00

(21)Application number: 03-090695

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

22.04.1991

(72)Inventor: N

NIIHORI HIROSHI SHIOMI TSUTOMU

(54) DISCHARGE LAMP LIGHTING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To quickly detect a lamp voltage of a discharge lamp.

CONSTITUTION: One end of a discharge lamp DL is connected to a connecting point of switching elements Q1, Q2 via an inductor L1, the other end of the discharge lamp DL is connected to a connecting point of switching elements Q3, Q4 via an inductor L2 having an inductance value almost equal to that of the inductor L1, and a capacitor C0 is connected in parallel with the discharge lamp DL Moreover, a voltage detecting means (not illustrated) for detecting voltages VA, VB across the discharge lamp DL is also provided. Thereby, the voltage across the discharge lamp DL is not varied due to high frequency switching operation of the switching elements Q1 to Q4. Accordingly, an integration circuit for controlling voltage variation is no longer required and delay of detection by integration can be eliminated. As a result, a lamp voltage of the discharge

lamp DL can be detected quickly and ON OFF states of the first to fourth switching elements Q1 to Q4 can be controlled depending on the condition change of the discharge lamp DL.

対応なし、英沙

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-322169

(43)公開日 平成4年(1992)11月12日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

H02M

E 8730-5H

7/48 7/5387

8730-5H

H 0 5 B 41/24

K∷7913-3K

// H02M 1/00 8325-5H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-90695

(22) 出願日

平成3年(1991)4月22日

(71)出願人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(72)発明者 新堀 博市

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工

株式会社内

(72)発明者 塩見 務

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工

株式会社内

(74)代理人 弁理士 宮井 暎夫

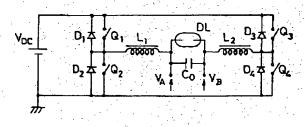
(54) 【発明の名称】 放電灯点灯装置

(57)【要約】

を設ける。

【目的】 放電ランプのランプ電圧を高速に検出する。 【構成】 スイッチング素子Qi Q2 の接続点にイン ダクタLiを介して放電ランプDLの一端を接続し、ス イッチング素子Qa、Quの接続点にインダクタLuと インダクタンス値の略等しいインダクタし、を介して放 電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデ ンサC。を並列接続する。また、放電ランプDLの両端 の電位VA, Vaを検出する電位検出手段(図示せず)

【効果】 放電ランプDLの両端の電位がスイッチング 素子Q1 ~Q4 の高周波のスイッチングによる変動がな くなるので、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、 積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプ DLのランプ電圧を高速に検出することができ、放電ラ ンプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチ ング素子Q1~Q4のオンオフを制御することができ



第1のスイッチング素子

第2のスイッチング素子

第3のスイッチング素子

第4のスイッチング素子

しょ 第1のインダクタ

第2のインダクタ

1

【特許請求の範囲】

直流電源の正極と負極との間に第1およ 【贈求項1】 び第2のスイッチング素子をこの順に直列接続し、前記 直流電源の正極と負極との間に第3および第4のスイッ チング素子をこの順に直列接続し、前記第1および第2 のスイッチング素子の接続点に第1のインダクタを介し て放電ランプの一端を接続し、前記第3および第4のス イッチング素子の接続点に前記第1のインダクタとイン ダクタンス値の略等しい第2のインダクタを介して放電 ランプの他端を接続し、前記放電ランプにコンデンサを 並列接続し、前記放電ランプの両端の電位を検出する電 位検出手段を設け、前記第1および第4のスイッチング 素子のオンオフを繰り返させるとともに前記第2および 第3のスイッチング素子をオフに保持する第1の状態と 前記第2および第3のスイッチング素子のオンオフを繰 り返させるとともに前記第1および第4のスイッチング 素子をオフに保持する第2の状態とを交互に繰り返させ 前記電位検出手段の検出結果に基づいて前記第1,第 2. 第3および第4のスイッチング素子のオン期間とオ フ期間の長さを制御する制御手段を設けた放電灯点灯装

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば高圧放電ランプをフルブリッジインバータで矩形波点灯させる放電灯点灯装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図14に従来のこの種の放電灯点灯装置の回路図を示す。この放電灯点灯装置は、図14に示すように、直流電源 V_{DC} の正極と負極との間に第1および第2のスイッチング素子 Q_1 , Q_2 をこの順に直列接続するとともに、直流電源 V_{DC} の正極と負極との間に第3 および第4のスイッチング素子 Q_2 , Q_4 をこの順に直列接続し、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子 Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 に第1,第2,第3および第4のダイオード D_1 , D_2 , D_3 , D_4 をそれぞれ逆並列接続している。

【0003】そして、第1および第2のスイッチング素子Q1,Q2の接続点に放電ランプDLの一端を接続し、第3および第4のスイッチング素子Q3,Q4の接続点にインダクタし。を介して放電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデンサC0を並列接続している。また、放電ランプDLの両端の電位V1,V1(その差電圧はランプ電圧となる)を検出する電位検出手段(図示せず)を設けるとともに、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子Q1,Q2,Q1,Q4のオンオフを制御する制御手段(図示せず)を設けている。

【0004】以上のような構成の放電灯点灯装置は、制 電位 V_{\bullet} と電位 V_{\bullet} の差がランプ電圧 $V_{\bullet I}$ となるが、電御手段により、具体的には、第1および第4のスイッチ 50 位 V_{\bullet} , V_{\bullet} のそれぞれにスイッチング周波数でチョッ

ング素子Q1, Q4 のオンオフを高い周波数で繰り返させるとともに第2および第3のスイッチング素子Q1, Q3 をオフに保持する第1の状態と第2および第3のスイッチング素子Q1, Q4 をオフに保持する第2の状態とを低い周波数で交互に繰り返させる。

【0005】また、電位検出手段の検出結果に基づいて、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子Q1,Q2,Q3,Q4のオン期間の長さを制御することにより、ランブ電圧もしくランブ電流を制御する。上記の放電灯点灯装置は、放電ランプDLの両端の電位V1,V1はそれぞれ図15(a),(b)に示すようになる。図15において、SW1は第1および第4のスイッチング素子Q1,Q4のオンオフを高い周波数で繰り返させるとともに第2および第3のスイッチング素子Q2,Q1をオフに保持する第1の状態の期間であり、SW1は第2および第3のスイッチング素子Q1,Q4をオフに保持する第2の状態の期間である。

【0006】 Volはランプ電圧であり、電位 Volには、期間 S Wolではランプ電圧 Volが負極性に重量し、期間 S Wolではランプ電圧 Volが正極性に重量する。上記において、放電ランプD Lの両端の電位を検出する電位検出手段としては、例えば図16に示すような差動増幅器 D Aolが考えられ、先の放電ランプD Lの両端の電位 Voloを直流電源 Voloの負極側をグラウンドとして入力することで、差動増幅器 D Aolの出力電圧 Voloとして図17に示すようなランプ電圧 Voloを検出することができる。なお、図17では、期間 S Wolのではうンプ電圧 Voloを検出することができる。なお、図17では、期間 S Wolのでは入りに が正極性となり、期間 S Wolのでは負極性となっている

【0007】また、図16の差動増幅器DA。に代えて、図18に示すようなダイオードD11,抵抗R17およびコンデンサC。からなる検波回路DWを用いることで、簡易にランプ電圧V11を検出することができる。つまり、この検波回路DWは、電位V16を直流電源V16の負極側をグラウンドとして、半波整流および積分する構成であり、抵抗R17およびコンデンサC1の時定数を、期間SW1と期間SW2の切換周期に比べて充分に大きく設定しており、その出力電圧V02としては図19に示す電圧が得られる。なお、この電圧V02のビーク値はV1c+V11となる。ただし、直流電源電圧V16には一定とする。

[0008]

[発明が解決しようとする課題] 図14の回路に図16 の差動増幅器DA3を組み合わせた第1の従来例では、 電位VAと電位VBの差がランプ電圧VBとなるが、電位VA、VBのそれぞれにスイッチング周波数でチョッ 3

プされた電源電圧が同相分として重量される。このような信号電位の差を計算するには、差動増幅器 DA」が用いられる。しかし、差動増幅器 DA」は、同相分を除去する能力が同相分の周波数が高くなるに従って低下する性質がある。そのため、差動増幅器 DA」の出力に同相分が重量し、その除去のため、積分回路を付加する必要が生じる。

【0009】また、図14の回路に図18の検波回路DWを組み合わせた第2の従来例では、半周期の電圧を積分回路により作っているため、切換周期に対して十分に 10長い時定数を有していなければならない。このように、ランプ電圧Vnの検出回路に積分回路を挿入する必要が生じる。しかし、積分回路の時定数が長いと、実際の放電ランプDLの状態に対して検出に時間遅れが発生するため、放電ランプDLの状態に応じた制御を行うことができないという問題があった。

【0010】 したがって、この発明の目的は、放電ランプのランプ電圧を高速に検出することができる放電灯点 灯装置を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】この発明の放電灯点灯装置は、図1に示すように、直流電源Vncの正極と負極との間に第1および第2のスイッチング素子Qn , Qz をこの順に直列接続するとともに、直流電源Vncの正極と負極との間に第3および第4のスイッチング素子Qn , Q4 をこの順に直列接続している。そして、第1および第2のスイッチング素子Qn , Q2 の接続点に第1のインダクタLn を介して放電ランプDLの一端を接続し、第3および第4のスイッチング素子Qn , Q4 の接続点に第1のインダクタLn とインダクタンス値の略等しい第2のインダクタLn を介して放電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデンサC。を並列接続している。

【0012】また、放電ランプDLの両端の電位 VA, Va を検出する電位検出手段(図示せず)を設け、第1 および第4のスイッチング素子Q1, Q4 のオンオフを繰り返させるとともに第2 および第3のスイッチング素子Q1, Q3 をオフに保持する第1の状態と、第2 および第3のスイッチング素子Q2, Q5 のオンオフを繰り返させるとともに第1 および第4のスイッチング素子Q1, Q4 をオフに保持する第2の状態とを交互に繰り返させ、電位検出手段の検出結果に基づいて第1, 第2, 第3 および第4のスイッチング素子Q1, Q2, Q3, Q4 のオン期間とオフ期間の長さを制御する制御手段を設けている。

 $\{0\ 0\ 1\ 3\}$ D_1 \sim D_4 はスイッチング素子 Q_1 \sim Q_4 に逆並列接続したダイオードである。なお、第1および第2のインダクタ L_1 , L_2 は鉄心が共通であっても、独立していても、どちらでもよい。

[0014]

【作用】この発明の構成によれば、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1および第2のインダクタレ1, Li を設けたため、第1ないし第4のスイッチング素子Q1 ~Q4 の高周波のスイッチングによる放電ランプDLの両端の電位の変動がなくなる。したがって、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプDLのランプ電圧を高速に検出することができ、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子Q1 ~Q4 のオンオフを制御することができる。

【0015】 【実施例】

(第1の実施例) この発明の第1の実施例を図2ないし図4に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2に示すように、放電ランプDLの一端を第1および第2のスイッチング素子Q1, Q2 の接続点に第1のインダクタL1を介して接続し、放電ランプDLの他端を第3 および第4のスイッチング素子Q1, Q4 の接続点に第2のインダクタL2 を介して接続している。第1および第2のインダクタL1, L2 はインダクタンス値が降等しく設定され、その直列合成インダクタンス値が従来のインダクタし。と同じに設定される。

【0016】また、放電ランプDLの両端の電位 V_A , V_1 はダイオード D_5 , D_6 および抵抗 R_1 からなる最大値検出回路 MX_1 で検出され、電位 V_A , V_2 の最大値が出力電圧 $V_{0.5}$ として出力される。この場合、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1おいし第4のスイッチング素子 Q_1 へ Q_4 の高周波のスイッチングによる放電ランプDLの両端の電位 V_A , V_3 の変動がなくなる。したがって、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプDLのランプ電圧を高精度かつ高速に検出することができ、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子 Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 のオンオフを制御することができ、例えばランプ電圧, ランプ電流等の変動を抑制することができる。

[0017] しかも、回路構成は、ダイオードDs.D。 および抵抗R1 からなる最大値検出回路MX1 を使用するだけであり、きわめて簡単な回路で電圧検出を行うことができる。また、図13のように、インパータIV (第1~第4のスイッチング素子Q1~Q4 からなる)から放電ランプDLへ至る2本のケーブルが地絡事故を起こしても、両側のケーブルにインダクタL1, L2 が挿入されているので、このインダクタL1, L2 で電流制限され、スイッチング素子Q1~Q4 が破壊することはない。

【0018】図3は図2の放電灯点灯装置における最大 50 値検出回路MX、の入出力電圧を示すもので、(a)は 5

【0019】図4はランプ電圧Volの変化に伴う電圧Volの変化を示す特性図であり、Voloは無負荷ランプ電 10 圧である。

(第2の実施例) この発明の第2の実施例を図5および 図6に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2における最大値検出回路MX1に代えて、ダイオードD, および抵抗R, よりなる最小値検出回路MI1を用いたもので、その他の構成は図2の放電灯点灯装置と同様である。

【0020】この実施例でも、前記第1の実施例と同様に、電圧変動抑制用の積分回路を要せずにランプ電圧を高精度かつ高速に検出することができる。したがって、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子Q1,Q1,Q1,Q1のオンオフを制御することができ、例えばランプ電圧、ランプ電流等の変動を抑制することができる。

【0021】しかも、回路構成は、ダイオード D_7 , D_1 および抵抗 R_2 からなる最小値検出回路 M_1 1 を使用するだけであり、きわめて簡単に電圧検出を行うことができる。この実施例における最小値検出回路 M_1 1 の出力電圧 V_0 4 は、電位 V_A , V_B 0 最小値を出力するので、常に(V_{BC} $-V_{B1}$) / 2 となる。

【0022】図6はランプ電圧Volの変化に伴う電圧Volの変化を示す特性図である。

(第3の実施例) この発明の第3の実施例を図7および 図8に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2 の最大値検出回路MX,に代えて、差動増幅器DA,を 用いたもので、その他の構成は図2の放電灯点灯装置と 同様である。

【0023】この実施例でも、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1および第2のインダクタL1、L2を設けたため、第1ないし第4のスイッチング素子Q1、Q2、Q3、Q4の高周波のスイッチングによる放電ランプDLの両端の電位V4、V3の変動がなくなる。したがって、第1の従来例のように、同相成分除去機能の高い差動増幅器を必要とせずに、あるいは積分回路を必要とせずに高精度かつ高速にに電圧検出を行うことができる。

【0024】また、放電ランプDLへ至る配線をインパータIVから引き出してもコモンモードノイズの発生が少ない。その他の効果は前記各実施例と同様である。

(第4の実施例) この発明の第4の実施例を図9に基づ 50

いて説明する。この放電灯点灯装置は、放電ランプDLの両端の電位 VA, VI を図7のように直接差動増幅器DA:に加えるのではなく、それぞれ抵抗R: およびコンデンサC:よりなる平均値回路と、抵抗R。およびコンデンサC:よりなる平均値回路とで、電位 VA, VIの平均値 VA', VI を求めた後、この差動増幅器DA:へ入力している。この場合、抵抗R:およびコンデンサC:の時定数ならびに抵抗R:およびコンデンサC:の時定数は、それぞれ期間 SW:,SW:の切換周期にくらべて十分に大きく設定している。その他は図2と同様である。

【0025】以上のような構成では、電位 V_A の平均値 V_A 、および電位 V_B の平均値 V_B 、が両者ともに V_B に /2となるので、通常は差動増幅器 DA_B の出力電圧 V_B には零である。しかし、図13に示すように、インバー91 Vから放電ランプDL へ向かう電源線の1 本が地絡した場合、 V_A 、 $=V_B$ 、 $=V_B$ に /2 ではなくなるので、電圧 V_B には何らかの電圧が出力される。これにより、インバー/2 V /2 V /3 V /4 V /4

【0026】その他の構成効果は先の従来例と同様である。

(第5の実施例) この発明の第5の実施例を図10および図11に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2の最大値回路MX1に代えて、抵抗減衰回路を含む最大値回路MX2を用いたもので、その他の構成は図2と同様である。

【0027】この最大値回路MX:は、分圧抵抗Rs,Rs,Rs,Rs,Rs,Rs,EhランジスタQs,Qs,Qs,Qrと、負荷抵抗Rs,Rs,Rs,Eh与ンジスタQs,Qs,Qrと、負荷抵抗Rs,Rs,Rs,Et抵抗Rs,Rs,Et抵抗αが等しく、分圧抵抗Rs,Rs,Et抵抗Rs,Rs,Et低位Vs,E分圧抵抗Rr,Rs,Ch上し、電位Vs,E分圧抵抗Rr,Rs,Ch上し、電流増幅を兼わるNPN型のトランジスタQs,Qs,Cm分圧電圧の最大値を選択し、トランジスタQs,Qs,Cp,Et和分配のPNP型のトランジスタQr,のエミッタフォロワを通して出力電圧Vorを取り出している。なお、Vccは制御電源電圧で、Vor≦Vccである。なお、Vccは制御電源電圧で、Vor≦Vccである。

[0028] 上記のように構成するのは以下のような理由があるからである。一般に、検出した電圧を使用する制御回路は、インパータ回路に比べてかなり低い電圧を使用するため、電位 Va, Va をそのまま検出するのではなく、滅衰させて使用するのが普通である。滅衰器を挿入して最大値を出力するものとして、図11のように、図2の最大値回路 MX, に単に分圧抵抗 Ra, Ra, Rr, Ra を付加しただけの最大値回路 MX, が考えられるが、この回路では、負荷抵抗 Ra の影響で、減衰率 Rr / (R1 + Rr) を正確に維持することができない。

・ 【0029】そこで、図10に示した回路のように、ダ

イオードD。, Dioに代えて、電流増幅を兼ねたNPN 型のトランジスタQs、Qsを使用して構成し、減衰率 を負荷抵抗R₁の影響を受けずに正確に維持するととも に、トランジスタQs , Qeの反対導電型のPNP型ト ランジスタQ¹ および負荷抵抗R₁₀からなるエミッタフ ォロワ回路を設けて、トランジスタQs , Qe の温度特 性を補償するようにしている。

[0030] この実施例では、放電ランプDLの両端の 電位V, V, を減衰させた状態で最大値を検出するこ とができ、しかも滅衰率を正確に維持することができる。10 とともに、温度変化に対する変動も無くすることができ る。その他の効果は第1の実施例と同様である。

(第6の実施例) この発明の第6の実施例を図12に基 づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図5の最小値 回路M I 」に代えて、抵抗減衰回路を含む最大値回路M 12 を用いたもので、その他の構成は図ると同様であ

A... KIS, KILCTULLAND WE , WE , WILD CE 負荷抵抗Ris; Ris EDIE TO DELLE REPORT REAL 抵抗値が等しく、分圧抵抗Rix、Rixは抵抗値が等し い。この最小値回路MI。は、電位V〟を分圧抵抗 R11, R12で分圧し、電位V1を分圧抵抗R13, R14で 分圧し、多二

タQ:,Q:と反対導電型のNPN型のトランジスタQ 10のエミッタフォロワを通して出力電圧 Voaを取り出し ている。なお、Vccは制御電源電圧で、Vos≦Vccであ

【0032】この最小値回路MI2は、電流増幅を兼ね たNPN型のトランジスタQ5, Q6 を使用して構成 し、減衰率を負荷抵抗R。の影響を受けずに正確に維持 するとともに、トランジスタQs , Qs の反対導電型の PNP型トランジスタQ7 および負荷抵抗R10からなる エミッタフォロワ回路を設けて、トランジスタQ。, Q 。の温度特性を補償するようにしている。

【0033】この実施例では、放電ランプDLの両端の 電位V_A, V, を減衰させた状態で最小値を検出するこ とができ、しかも減衰率を正確に維持することができる とともに、温度変化に対する変動も無くすることができ 40 る。なお、上記各実施例のインダクタレ1, し1 は、同 一鉄心に巻線を巻回したものでも、また別々の鉄心に巻 回したものでも、どちらでもよい。

[0034]

【発明の効果】この発明の放電灯点灯装置によれば、放 電ランプの両側にインダクタンス値の略等しい第1およ び第2のインダクタを設けたため、第1ないし第4のス イッチング素子の高周波のスイッチングによる放電ラン プの両端の電位の変動をなくすことができる。 したがっ て、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分によ 50 $m L_1$ 第1のインダクタ

る検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプのランプ 電圧を高速に検出することができ、放電ランプの状態変 化に即して第1ないし第4のスイッチング素子のオンオ フを制御することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の放電灯点灯装置の構成を示す回路図

【図2】この発明の第1の実施例の放電灯点灯装置の回 路図である。

【図3】図2の各部のタイムチャートである。

【図4】図2の回路におけるランプ電圧Vilの変化に対 する電圧Vosの変化を示す特性図である。

【図5】この発明の第2の実施例の放電灯点灯装置の要 部の構成を示す回路図である。

【図6】図5の回路におけるランプ電圧Vn1の変化に対 する電流Vosの変化を示す特性図である。

【図7】この発明の第3の実施例の放電灯点灯装置の要 ※窓図である。

INIO / NO / の回路の出力電圧のタイムチャートであ

[図9] この発明の第4の実施例の放電灯点灯装置の要 部の構成を示す回路図である。

【図10】この発明の第5の実施例の放電灯点灯装置の 要部の構成を示す回路図である。

【図11】参考となる最大値回路の回路図である。

【図12】この発明の第6の実施例の放電灯点灯装置の 要部の構成を示す回路図である。

【図13】放電灯点灯装置の地絡の様子を示す概略図で

【図14】放電灯点灯装置の従来例を示す回路図であ

【図15】図14の回路の各部のタイムチャートであ

【図16】放電ランプの両端電圧を検出する部分の回路 図である。

【図17】図16の回路の出力電圧のタイムチャートで

【図18】放電ランプの両端電圧を検出する部分の回路 図である。

【図19】図18の回路の出力電圧のタイムチャートで ある。

【符号の説明】

直流電源

第1のスイッチング素子 Q_1

Q: 第2のスイッチング素子

第3のスイッチング案子

Ω₄ 第4のスイッチング案子

DL 放電ランプ

コンデンサ

